

Прижимная конструкция
 Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Штыревой Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ175-200-14

Средний прямой ток		I _{TAV}	200 А	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии		U _{DRM}	1000 ÷ 1400 В	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U _{RRM}		
Время выключения		t _q	20.0; 25.0 мкс	
U _{DRM} , U _{RRM} , В	1000		1200	1400
Класс по напряжению	10		12	14
T _j , °C			– 60 ÷ 125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	A	200 410	T _c =99 °C; T _c =55 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	A	314	T _c =99 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	kA	6.5 7.5	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _D =U _R =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=1 A/мкс
			7.0 8.1	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _D =U _R =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=1 A/мкс
I ² t	Защитный фактор	A ² с10 ³	210 280	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _D =U _R =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=1 A/мкс
			200 270	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _D =U _R =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=1 A/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000÷1400	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100÷1500	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	6	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	1600	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60 ÷ 125	
T_j	Температура p-n перехода	°C	-60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	1.5 ÷ 2.5	
a	Ускорение	м/с ²	100	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

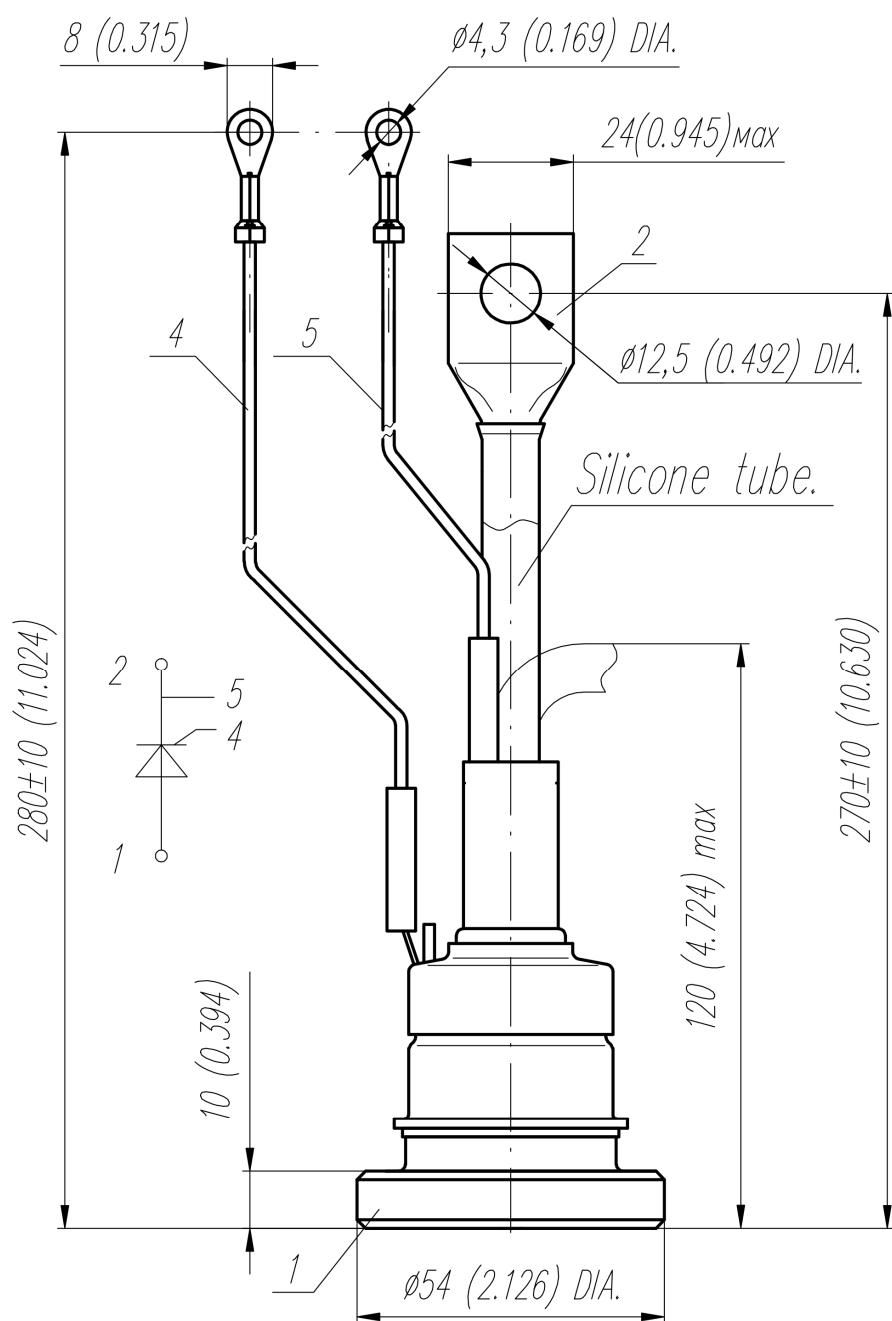
Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.96
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.31
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	мОм	1.100
I_H	Ток удержания, макс	мА	500
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	70
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	1000
			$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
			$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления					
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	400 250 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.25	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 U_{DRM};$	Постоянный ток управления
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	10.00		
Динамические характеристики					
t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.00	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 V_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}; V_G = 20 V;$ $t_{GP} = 50 \mu s; di_G/dt = 1 A/\mu s$	
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	20.0; 25.0	$dv_D/dt = 50 V/\mu s; T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 A/\mu s; U_R = 100 V;$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$	
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	150	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$	
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	3.2	$di_R/dt = -50 A/\mu s;$ $U_R = 100 V$	
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	A	94		
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ C/W$	0.0700	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	500		
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	12.4 (4.882)		
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.4 (4.882)		

ПРИМЕЧАНИЕ		МАРКИРОВКА						
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии								
Обозначение группы								
$(dv_D/dt)_{crit}, V/\mu s$								
A2								
1000								
2) Время выключения ($dv_D/dt = 50 V/\mu s$)								
Обозначение группы								
P3								
$t_q, \mu s$								
20.0								
25.0								

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: T.SB3



Полярность	Пример маркировки	Условное обозначение	Цвета		
			Анод	Катод	Управление
Анод на основании	ТБИ175-200-14		-	Красная трубка	Белый

Все размеры в миллиметрах (дюймах)